

2011 年 7 月 19 日

## 新款功率 MOSFET 器件的技术参数

| 产品编号   | 封装     | 漏极-源极电压 [VDSS] (V) | 栅极-源极电压 [VGSS] (V) | 漏极电流 [ID] (A) | 导通状态电阻 [RDS(on)] (VGSS = 10 V)(mΩ) |     | 总栅极电荷 [Qg] (nC) | 输入电容 [Ciss] (pF) |
|--------|--------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----|-----------------|------------------|
|        |        |                    |                    |               | 典型值                                | 最大值 |                 |                  |
| N0412N | TO-220 | 40                 | ±20                | 100           | 3.0                                | 3.7 | 97              | 6000             |
| N0434N | TO-262 | 40                 | ±20                | 100           | 3.0                                | 3.7 | 97              | 6000             |
| N0413N | TO-263 | 40                 | ±20                | 100           | 2.7                                | 3.3 | 97              | 6000             |
| N0602N | TO-220 | 60                 | ±20                | 100           | 3.6                                | 4.6 | 148             | 8000             |
| N0603N | TO-262 | 60                 | ±20                | 100           | 3.6                                | 4.6 | 148             | 8000             |
| N0601N | TO-263 | 60                 | ±20                | 100           | 3.3                                | 4.2 | 148             | 8000             |